

IMB2

アイソレーテッドミニモールドデバイス インバータドライバ/Inverter Driver Isolated Mini-Mold Device

● 特長

- 1) SMT (SC-59) と同一体積に 2 個のトランジスタが入っている。
- 2) SMTの自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 2個のトランジスタの特性がそろっている。
- 4) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) The characteristics of 2 transistors are uniform.
- 4) No mutual interference exists between each transistor.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits		Unit
		Tr ₁ (PNP)	Tr ₂ (PNP)	
電源電圧	V _{CC}	-50	-50	V
入力電圧	V _{IN}	-40	-40	V
		10	10	V
出力電流	I _O	-30	-30	mA
許容損失	P _d	300(TOTAL)*		mW
保存温度範囲	T _{stg}	-55~125		°C

* ただし、1素子当り200mWをこえないこと。/However, 200mW should not be exceeded per element.

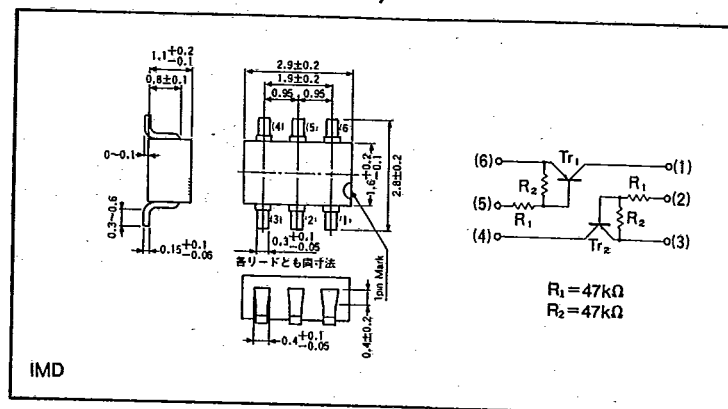
● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	V _I (OFF)	—	—	-0.5	V	V _{CC} =-5V, I _O =-100μA
	V _I (ON)	-3.0	—	—	V	V _O =0.3V, I _O =-2mA
出力電圧	V _O (ON)	—	-0.1	-0.3	V	I _O =-10mA, I _I =-0.5mA
入力電流	I _I	—	—	-0.18	mA	V _I =-5V
出力電流	I _O (OFF)	—	—	-10	μA	V _{CC} =-30V, V _I =0V
直流電流増幅率	G _I	68	—	—	—	I _O =-5mA, V _O =-5V
入力抵抗	R ₁	—	47	—	kΩ	—
抵抗比率	R ₂ /R ₁	0.8	1.0	1.2	—	—

注：各特性は個々のデジタルトランジスタ(DTr₁, DTr₂)に対する規格です。

Note: Each characteristic relates to the standard for individual digital transistors (DTr₁, DTr₂).

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



トランジスタ

IMDタイプ

T-43-90

● 標準品・準標準品一覧表

(○: 準標準品)

Type	包装名	テーピング
	記号	T110
	基本発注単位(個)	3 000
IMB2		○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

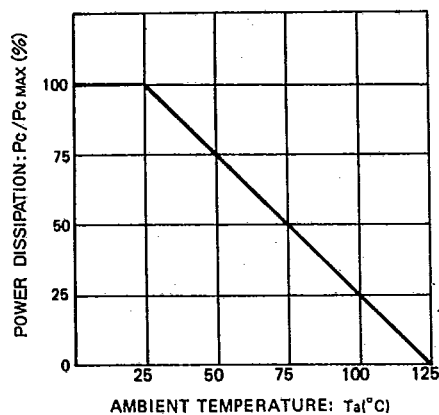


Fig.1 電力軽減曲線

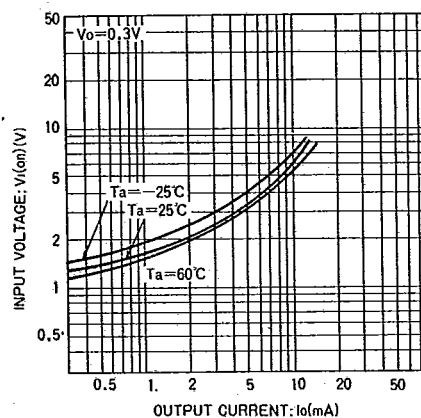


Fig.2 入力電圧—出力電流 (ON特性)

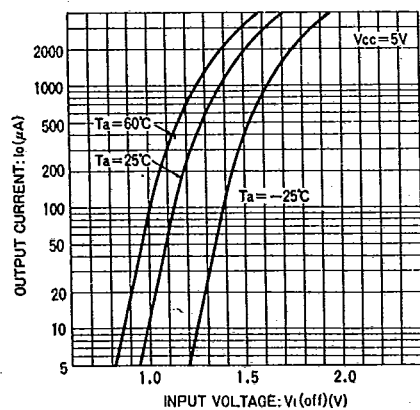


Fig.3 出力電流—入力電圧 (OFF特性)

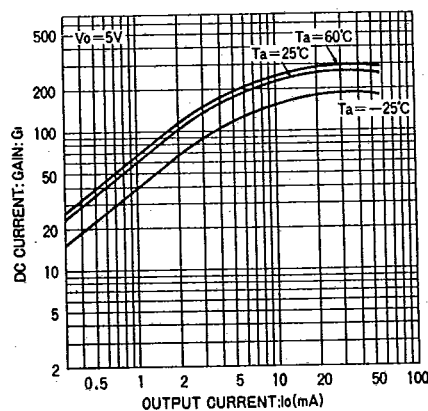


Fig.4 直流電流増幅率—出力電流特性